



嘉兴斯达半导体股份有限公司

2021 年度非公开发行 A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

二〇二一年六月

一、本次非公开发行股票募集资金使用计划

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 350,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目	150,000.00	150,000.00
2	SiC 芯片研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
3	功率半导体模块生产线自动化改造项目	70,000.00	70,000.00
4	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		350,000.00	350,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目

1、项目基本情况

本项目拟通过新建厂房及仓库等配套设施，购置光刻机、显影机、刻蚀机、PECVD、退火炉、电子显微镜等设备，用于实施高压特色工艺功率芯片的研发和产业化项目。项目达产后，预计将形成年产 30 万片 6 英寸高压特色工艺功率芯片生产

能力。

本项目实施主体为公司全资子公司嘉兴斯达微电子有限公司。

2、项目建设的必要性

(1) 满足智能电网、轨道交通、风力发电行业高压功率芯片的市场需求，丰富公司产品线

高压特色工艺功率芯片广泛应用于智能电网、轨道交通、风力发电等市场。目前国内以智能电网、轨道交通、风力发电为代表的高端行业应用的功率芯片主要还是被国外品牌所垄断。随着轨道交通、智能电网、风力发电等产业的持续向好，我国已逐步发展为全球特色工艺功率芯片及功率半导体器件的核心增长区域市场，国外高压特色功率芯片供不应求，为国内 IGBT 厂商提供国产化替代的机遇。本项目的实施有助于加快高压特色工艺功率芯片领域的布局，丰富公司产品线，满足智能电网、轨道交通、风力发电行业对高压功率芯片的市场需求。

(2) 加快我国高压特色工艺功率芯片的技术突破，实现智能电网、轨道交通、风力发电行业高压功率器件的国产化替代

在智能电网行业，高压 IGBT 是柔性直流换流阀必不可少的核心功率器件，目前，国内建成及在建的柔性直流输电工程包括舟山 400MW 柔性直流输电工程、厦门 1000MW 柔性直流输电工程、云南鲁西 1000MW 柔性直流输电工程、张北 3000MW 柔性直流输电工程等，柔性直流输电技术是未来智能电网技术的重点发展方向。

在轨道交通行业，高压 IGBT 是轨道交通列车“牵引变流器”的核心器件，而牵引变流器是驱动轨道交通列车行驶最关键的部件之一。轨道交通作为一种安全可靠、快捷舒适、运载量大、低碳环保的运输方式，在全世界范围内得到迅速推广。在我国，轨道交通行业是关系国计民生的基础性行业之一，亦是中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策重点支持的战略新兴产业。《中长期铁路网规划（2016

年调整）》《交通强国建设纲要》《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》《新时代交通强国铁路先行规划纲要》等产业政策为我国轨道交通行业的发展规划了广阔的前景。

在风力发电行业，高压 IGBT 是风力发电行业“风电变流器”的核心功率器件。“十三五”以来，我国海上风电快速发展，已成为仅次于英国和德国的世界第三大海上风电国家。“十四五”是实现 2030 年非化石能源占一次能源消费比重 20% 目标的关键期，在此期间我国海上风电仍将继续保持快速发展，成为新能源发电新的增长极。目前海上风力发电的风机功率等级主要以 2-7MW 为主，未来风机的功率将达到 10-20MW，3300V 以上 IGBT 在风力发电行业具有广阔的应用前景。

目前国内 3300V 及以上功率器件基本依赖进口，亟需发展国产核心功率半导体器件，助力智能电网、轨道交通、风力发电行业核心器件的国产化。

（3）加速企业自主知识产权技术成果产业化，全面提升核心竞争力

嘉兴斯达微电子有限公司是嘉兴斯达半导体股份有限公司的全资子公司。随着中国集成电路产业高质量发展战略实施，斯达微电子依托母公司在功率半导体的技术积累，在 600V/650V、1200V、1700V 等中低压 IGBT 芯片已经实现国产化，但是在 3300V、4500V 等高压功率芯片仍依赖进口，急需国产化以提高公司的竞争力。本项目的实施将有助于企业把握市场和政策机遇，进行具有自主知识产权的技术突破和成果产业化，完善产品技术和产能布局，提升核心竞争力。

3、项目建设的可行性

（1）国家相关产业政策为项目实施提供良好政策环境

本项目产品符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（修订）鼓励类“二十八、信息产业”中“21、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”；2016 年 3 月全国两会发布“十三五规划”，针对

功率器件行业：加强与整机产业的联动，以市场促进器件开发、以设计带动制造、推动“虚拟 IDM”运行模式的发展；建设国家级半导体功率器件研发中心，实现从“材料-器件-晶圆-封装-应用”全产业链的研究开发。2017 年国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》将“电力电子功率器件（绝缘栅双极晶体管芯片（IGBT）及模块）”纳入重点培育和发展的战略性新兴产业范围；2020 年国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，重点支持高端芯片关键核心技术研发和产业化；科技部在国家科技支撑计划重点项目《电力电子关键器件及重大装备研制》中，重点支持 IGBT 芯片和模块的研发；工信部在电子发展基金中也对 IGBT 器件及模块进行了资助，推动了 IGBT 芯片自主研发的发展；国家政策的大力支持给功率半导体器件行业的发展带来了良好的机遇，以 IGBT 为代表的新兴功率半导体器件，在技术和国内市场占有率都取得了很大的进步。

（2）下游市场发展前景广阔

高压特色工艺功率芯片受下游智能电网、轨道交通、风力发电等行业需求拉动，市场规模增长快速。智能电网方面，据中商产业研究院预测，到 2020 年我国智能电网行业市场规模将近 800 亿元，在庞大的市场需求的驱动下，高压功率模组市场潜力巨大。轨道交通方面，根据中信证券研究报告，中国地铁高压功率模组需求在 2021-2023 年将维持 15%-20% 的年复合增长率，铁路需求将维持平稳，年化需求预计在 15 亿元左右。在风力发电行业，2019 年全球风电新增装机容量为 60.4GW，较 2001 年增长超过 8 倍，年均复合增长率为 13.18%。风电作为现阶段发展最快的可再生能源之一，在全球电力生产结构中的占比正在逐年上升，拥有广阔的发展前景。根据 GWEC 的预测，未来 5 年全球将新增超过 355GW 装机容量，在 2020-2024 年间每年新增装机容量均超过 65GW。上述下游产业的快速发展将为高压特色工艺功率芯片产业带来巨大的发展动力。

（3）公司具备了项目实施的人才、技术、市场等各项必要条件

公司深耕功率半导体行业多年，有深厚的技术积累和丰富的人才储备，在国内外均设有研发中心。公司技术骨干主要是来自美国麻省理工学院、台湾清华大学、浙江大学等国际知名高校的博士或硕士，大多数具备在国际知名半导体企业承担研发工作的经历，在功率半导体芯片和模块领域有 20 年以上的研发和生产经验，在高压特色工艺功率芯片设计和制造领域拥有成熟的技术经验。公司成立了芯片和模块设计中心，建设完备的产品可靠性实验室和工况模拟实验室，购置先进的芯片、模块设计软件和热分析模拟软件，可实现产品的性能、动静态、工况模拟等测试。此外，公司在海外设立了欧洲研发中心，其研发人员拥有在国际知名半导体公司任职多年的背景，协同母公司进行尖端芯片和模块的研发及测试。公司拥有完善的营销网络布局和丰富的客户资源，与客户建立了长期稳定的合作关系，始终坚持以客户需求为价值导向，致力于面向应用的产品技术创新，确保公司能研发出符合客户技术要求的产品。公司具备了项目实施的人才、技术、市场等各项必要条件。

综上所述，高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目符合国家产业发展方向、广阔的下游市场、公司战略和业务发展的需要，公司具备实施本项目相关的人才、技术、市场储备及可持续的服务实力，本项目具有可行性。

4、项目投资计划

（1）投资金额

本项目总投资金额 150,000.00 万元，拟使用募集资金金额 150,000.00 万元。

（2）建设周期

本项目计划建设周期为 3 年。

5、项目备案事项

本项目已取得南湖区政府行政审批局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（登记备案项目代码：2103-330402-89-01-638473），已取得嘉兴市生态环境局出具的《嘉兴市生态环境局关于嘉兴斯达微电子有限公司高压特色工艺功率芯片和 SiC 芯片研发及产业化项目环境影响登记表的备案意见》（备案文号：嘉（南）环建备〔2021〕7 号）

（二）SiC 芯片研发及产业化项目

1、项目基本情况

本项目拟通过新建厂房及仓库等配套设施，购置光刻机、涂胶显影机、铝刻蚀机、高温注入机等设备，开展 SiC 功率芯片的研发和产业化。项目达产后，预计将形成年产 6 万片 6 英寸 SiC 芯片生产能力。

本项目实施主体为公司全资子公司嘉兴斯达微电子有限公司。

2、项目建设的必要性

（1）加快我国 SiC 芯片的技术突破，推动我国第三代功率半导体芯片进口替代步伐

第三代半导体材料功率器件具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的电子饱和速度，可以承受更高的电压、更高的热导率、更强的辐射，可广泛应用于高压高频高温以及高可靠性等领域。目前全球龙头企业均在布局第三代半导体材料功率器件产业化应用，与之相比我国第三代半导体材料功率器件在大批量工艺流程等方面还存在一定的技术短板，急需抓住功率半导体新材料升级机遇，拉齐与国外企业的差距。SiC 芯片作为目前主流的第三代半导体芯片，被广泛应用于新能源汽车等新兴高端行业市场。目前国内以新能源汽车行业应用的功率器件主要还是被国外品牌所垄断。随着新能源汽车的全面推广应用，我国已发展为全球特色工艺功率芯片及功率半导体器件的核心增长区域市场，实现 SiC 芯片自主研发和产业化的需求越来越迫切。本项目的实施有助于加快我国第三代半导体功率器件的技术突

破，抓住功率半导体行业新材料升级机遇，打破国外龙头企业垄断格局，改变当前新能源汽车基础设施关键零器件严重进口依赖的局面，推动 SiC 芯片国产化进程。

（2）把握新能源汽车市场机遇，迅速拓展新能源汽车市场份额

从新能源汽车领域看，据 EV Tank 预测，2025 年全球新能源汽车销量将超 1200 万辆，2019-2025 年年均复合增长率将达 32.6%。中国有全球最大的新能源汽车产业，其发展规模将长期保持高速扩展，市场空间广阔。在 2020 年 11 月 2 日，国务院印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》；《规划》指出到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，在三大电领域取得关键技术重大突破。纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新售新能源汽车达到汽车新车销售总量的 20%左右，按照目前规划，可以合理预测 2026 年中国新能源汽车销售量将达到 280 万辆左右，市场空间十分巨大。

目前市场上销售的新能源汽车所搭载的功率半导体多数为 IGBT 和 SiC MOSFET。由于 SiC MOSFET 较 IGBT 方案比，可以有效的提升新能源汽车持续续航能力、空间利用等关键性指标，同时还可以减小电机控制器的体积，以特斯拉为代表的部分中高端车型已经开始使用 SiC MOSFET 方案。随着 SiC 技术的进步和方案的成熟，SiC 芯片市场将随着新能源汽车市场的快速增长而迅速发展。

随着公司该项目的进行，公司将把握住新能源汽车市场机遇，迅速拓展新能源汽车市场份额。

（3）加速企业自主知识产权技术成果产业化，全面提升核心竞争力

嘉兴斯达微电子有限公司是嘉兴斯达半导体股份有限公司的全资子公司。随着中国集成电路产业高质量发展战略实施，斯达微电子依托母公司在功率半导体的技术积累，把握功率半导体器件向第三代材料迭代升级发展趋势和关键基础设施核心模块安全可控政策引领，进行技术和产能布局，向碳化硅芯片研发及产业化领域拓展，从而达到优化产品结构，完善产品布局的目的。目前公司在 600V/650V、1200V、

1700V 等中低压 IGBT 芯片已经实现国产化，但是 SiC 芯片仍依赖进口，急需国产化以提高公司的竞争力。为此，公司拟采用先进技术和设备，实施 SiC 芯片研发及产业化项目，产品由企业自主研发，具有完全自主知识产权，各项指标均达到国外同类产品技术要求，部分指标优于进口产品。因此，本项目的实施将有助于企业把握市场和政策机遇，进行具有自主知识产权的技术突破和成果产业化，完善产品技术和产能布局，提升核心竞争力。

3、项目建设的可行性

（1）国家相关产业政策为项目实施提供良好政策环境

本项目产品符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（修订）鼓励类“二十八、信息产业”中“21、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”；2016 年 3 月全国两会发布“十三五规划”，针对功率器件行业：加强与整机产业的联动，以市场促进器件开发、以设计带动制造、推动“虚拟 IDM”运行模式的发展；建设国家级半导体功率器件研发中心，实现从“材料-器件-晶圆-封装-应用”全产业链的研究开发；大力发展国产 IGBT 产业，促进 SiC 和 GaN 器件应用。2020 年国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，重点支持高端芯片关键核心技术研发和产业化；国家先后印发《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 版）》《能源技术创新“十三五”规划》等鼓励性、支持性政策，将 SiC、GaN 和 AlN 等第三代半导体材料纳入重点新材料目录，推动支持 SiC 等第三代半导体材料的制造及应用技术突破；国家 2030 计划和“十四五”国家研发计划已明确第三代半导体是重要发展方向；国家科技部、工信部、北京市科委牵头成立第三代半导体产业技术创新战略联盟（CASA），推动我国第三代半导体材料及器件研发和相关产业发展。国家政策的大力支持给功率半导体器件行业的发展带来了良好的机遇，以 SiC 为代表的第三代材料半导体功率器件领域，有望打破国外企业垄断局面，实现弯道超车。

（2）下游市场发展前景广阔

SiC 芯片受下游新能源汽车等行业需求拉动，市场规模增长快速。据 YOLE 统计，2018 年全球新能源汽车用 IGBT 模组市场规模达 9.09 亿美元，预计到 2024 年将增长到 19.10 亿美元，年复合增速 13.17%。随着 SiC 功率器件在新能源汽车行业的广泛应用，将会给 SiC 芯片带来巨大的市场空间。上述下游产业的快速发展将为高压特色工艺功率芯片和 SiC 芯片产业带来巨大的发展动力。

（3）公司具备了项目实施的人才、技术、市场等各项必要条件

公司深耕功率半导体行业多年，有深厚的技术积累和丰富的人才储备，在国内外均设有研发中心。公司技术骨干主要是来自美国麻省理工学院、台湾清华大学、浙江大学等国际知名高校的博士或硕士，大多数具备在国际知名半导体企业承担研发工作的经历，在功率半导体芯片和模块领域有 20 年以上的研发和生产经验，在 SiC 芯片设计和制造领域拥有成熟的技术经验。公司成立了芯片和模块设计中心，建设完备的产品可靠性实验室和工况模拟实验室，购置先进的芯片、模块设计软件和热分析模拟软件，可实现产品的性能、动静态、工况模拟等测试。此外，公司在海外设立了欧洲研发中心，其研发人员拥有在国际知名半导体公司任职多年的背景，协同母公司进行尖端芯片和模块的研发及测试。通过自主研发和技术创新，公司已拥有国际领先的生产工艺等核心技术，未来公司将以 IGBT 技术为基础，不断突破和积累下一代以 SiC 器件为代表的宽禁带功率半导体器件的关键技术，持续创新，持续保持核心技术竞争优势。公司拥有完善的营销网络布局和丰富的客户资源，与客户建立了长期稳定的合作关系，始终坚持以客户需求为价值导向，致力于面向应用的产品技术创新，确保公司能研发出符合客户技术要求的产品。公司具备了项目实施的人才、技术、市场等各项必要条件。

综上所述，SiC 芯片研发及产业化项目符合国家产业发展方向、广阔的下游市场、公司战略和业务发展的需要，公司具备实施本项目相关的人才、技术、市场储备及可持续的服务实力，本项目具有可行性。

4、项目投资计划

（1）投资金额

本项目总投资金额 50,000.00 万元，拟使用募集资金金额 50,000.00 万元。

（2）建设周期

本项目计划建设周期为 3 年。

5、项目备案事项

本项目已取得南湖区政府行政审批局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（登记备案项目代码：2103-330402-89-01-638473），已取得嘉兴市生态环境局出具的《嘉兴市生态环境局关于嘉兴斯达微电子有限公司高压特色工艺功率芯片和 SiC 芯片研发及产业化项目环境影响登记表的备案意见》（备案文号：嘉（南）环建备〔2021〕7 号）

（三）功率半导体模块生产线自动化改造项目

1、项目基本情况

本项目拟利用现有厂房实施生产线自动化改造项目，购置全自动划片机、在线式全自动印刷机、在线式全自动贴片机、在线式全自动真空回流炉、在线式全自动清洗机等设备，实施功率半导体模块生产线自动化改造项目。项目达产后，预计将形成新增年产 400 万片的功率半导体模块的生产能力。

本项目实施主体为嘉兴斯达半导体股份有限公司。

2、项目建设的必要性

（1）把握功率半导体市场快速发展机遇，满足市场需求

功率半导体主要用于电力设备的电能变换和电路控制，是进行电能处理的核心

器件，是弱电控制与强电运行之间的桥梁。随着世界各国对节能减排的需求越来越迫切，功率半导体器件已从传统的工业控制和 4C（通信、计算机、消费电子、汽车）领域迈向新能源、新能源汽车、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多产业。中国是全球最大的功率半导体消费国，智研咨询发布的《2020-2026 年中国功率半导体行业市场运作模式及投资前景展望报告》指出：目前中国的功率半导体市场规模占全球市场规模 35%左右，是全球最大的功率半导体市场，约为 940.8 亿元。在新基建的产业环境下，5G、新能源汽车、数据中心、工业控制等诸多产业对功率半导体产生了巨大的需求，随着功率半导体市场的持续发展与国产替代进程的加速，功率半导体具有广阔的市场前景。

（2）有助于提升企业质量管控能力，进一步提高公司产品质量稳定性

在功率半导体器件领域，以英飞凌为代表的海外头部企业进入较早，在设计技术、工艺水平、产品系列化等方面形成较强的优势，市场占有率较高。公司通过多年的技术积累，生产的 IGBT 模块和 SiC 模块已获得了众多国内外主流的下游生产厂商认可，产品性能和质量稳定性和海外品牌相当。本项目的实施有助于提升企业质量管控能力，进一步提高公司产品质量稳定性，从而增强公司产品综合竞争力。

（3）有助于进一步提升企业对下游市场的供货保障能力，提高客户供应链安全性，提升企业竞争力

随着工业控制、新能源、新能源汽车等下游市场的需求拉动，功率半导体器件呈现供不应求的局面。公司拟采用先进技术和设备，实施以 IGBT 和 SiC 为主的功率半导体模块生产线自动化改造项目，进一步扩大产能，保证公司在市场份额持续提高及下游需求迅速增长的情况下，充分保障客户需求，提升公司综合竞争力。

3、项目建设的可行性

（1）国家相关产业政策为项目实施营造了良好的政策环境

近年来，国家发布了一系列支持功率半导体行业的政策。2017 年国家发改委公

布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》将“电力电子功率器件（绝缘栅双极晶体管芯片（IGBT）及模块）”纳入重点培育和发展的战略性新兴产业范围；国家先后印发《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 版）》《能源技术创新“十三五”规划》等鼓励性、支持性政策，将 SiC、GaN 和 AlN 等第三代半导体材料纳入重点新材料目录，推动支持 SiC 等第三代半导体材料的制造及应用技术突破；科技部在国家科技支撑计划重点项目《电力电子关键器件及重大装备研制》中，重点支持 IGBT 芯片和模块的研发；工信部在电子发展基金中也对 IGBT 器件及模块进行了资助。国家相关产业政策为项目实施营造了良好的政策环境。

（2）产品覆盖多个下游应用领域，市场空间巨大

以 IGBT 模块、SiC 模块为代表的功率半导体模块广泛应用于电机节能、新能源、新能源汽车、智能电网、轨道交通、白色家电等领域，下游市场规模巨大。IHS 调研数据显示，2018 年全球 IGBT 市场规模达 62 亿美元。据集邦咨询《2019 中国 IGBT 产业发展及市场报告》显示，中国是全球最大的 IGBT 市场，2018 年中国 IGBT 市场规模约为 153 亿人民币，相较 2017 年同比增长 19.91%。受益于工业控制、新能源、新能源汽车等领域的需求大幅增加，中国 IGBT 市场规模将持续增长，到 2025 年，中国 IGBT 市场规模将达到 522 亿人民币，年复合增长率达 19.11%。

（3）成熟的模块设计、制造、测试能力，为本项目的顺利实施提供充分保障

公司自成立以来一直以技术发展和产品质量为公司之根本，并以开发新产品、新技术为公司的主要工作，持续大幅度地增加研发投入，培养、组建了一支高素质的国际型研发队伍。团队的技术能力涵盖了模块的设计、工艺开发、产品测试、产品应用等方面，在半导体技术、电力电子、控制、材料、力学、热学、结构等多学科具备了深厚的技术积累。公司成熟的模块设计、制造、测试能力为本项目的顺利实施提供充分保障。

4、项目投资计划

（1）投资金额

本项目总投资金额为 70,000.00 万元，拟使用募集资金金额 70,000.00 万元。

（2）建设周期

本项目计划建设周期为 3 年。

5、项目备案事项

本项目已取得南湖区政府行政审批局出具的《浙江省外商投资项目备案（赋码）信息表》（登记备案项目代码：2104-330402-89-02-189917），已取得嘉兴市生态环境局出具的《嘉兴市生态环境局关于嘉兴斯达半导体股份有限公司功率半导体模块生产线自动化改造项目环境影响登记表的备案意见》（备案文号：嘉（南）环建备〔2021〕8 号）

（四）补充流动资金

1、项目基本情况

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次非公开发行股票募集资金补充流动资金 80,000.00 万元。

2、项目实施的必要性

当前公司资金实力相对不足。尽管公司已经在以 IGBT 为主的功率半导体行业取得较为明显的竞争优势，处于行业领先地位，但公司在营收规模、利润水平等方面还处于迅速发展阶段。随着公司产品规模的扩张、技术研发投入的增加、人才团队的扩充，公司在资金实力方面的制约愈发明显，资金的不足限制了公司的进一步发展。

公司通过本次非公开发行 A 股股票募集资金补充相应流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，从而提升

公司的行业竞争力；又将改善公司流动性指标，降低公司财务风险与经营风险，使公司财务结构更加合理，业务经营更加稳健。

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。本次募集资金投资项目有助于优化公司业务结构，提升公司经营管理能力，提高公司盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资金实力将大幅增强，资产负债率水平有所降低，财务结构更趋合理，有利于进一步优化资产结构，降低财务风险，增强未来的持续经营能力。同时，由于本次发行后总股本将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法迅速体现，因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的可能性。但是，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。

四、可行性分析结论

综上所述，本次非公开发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司市场地位，符合全体股东的根本利益。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日